

★ 2025년 1월 1일부터 다음 변경일까지

구분	장비명	서비스이용료 (VAT별도)			단위	공정내용	비고
		기본료	재료비	단가(원)			
전처리 세정	UV Ozone Cleaner			20,000	장	UV Ozone Cleaning	370mm x 470mm 이하 기판, 시편, Wafer
	AP Plasma machine			30,000	장	O2 Plasma treatment	2"~ 16" 및 조각 시편, 420mm x 520mm 이하 사각 기판, Max O2 200sccm, Max Power 600W
	Asher			100,000	장	O2 Vacuum Plasma Ashing	2"~ 16" 및 조각 시편, 415mm x 510mm 이하 사각 기판, Max O2 500sccm, Max Power 500W
	Ultrasonic Cleaner			30,000	장	Ultrasonic cleaning	2"~ 17" 및 조각 시편, 450mm x 550mm 이하 사각 기판, Max Power 1500W
증착	Sputter	200,000		180,000	Batch	메탈타겟: Ag (증착두께 200nm기준)	2"~16" 및 조각 시편, 415mm x 510mm 이하 사각 기판 (증착 기준두께 +100nm 증가 시마다 3만원 추가)
		200,000		120,000	Batch	메탈타겟: ITO	2"~16" 및 조각 시편, 415mm x 510mm 이하 사각 기판 (증착 기준두께 +100nm 증가 시마다 3만원 추가)
		200,000		100,000	Batch	메탈타겟: Ti, TiN, Cu, Al, Cr, Mo, Si, Ni, Sn, In	2"~16" 및 조각 시편, 415mm x 510mm 이하 사각 기판 (증착 기준두께 +100nm 증가 시마다 3만원 추가)
포토	Spin Coater	300,000	별도	30,000	장	Resist Coating	2" ~ 8" 및 조각 시편, 40mm 이상 ~ 150mm 이하 사각 기판, PR재료 별도
		300,000	별도	50,000	장	Resist Coating	12"~ 13.4" 및 조각 시편, 150mm 초과 ~ 510mm 이하 사각 기판, PR재료 별도
	DFR Laminator	100,000	별도	50,000	장	Roll Lamination	2"~19" Wafer 및 조각 시편, 500mm x 500mm 이하 사각 기판, 500mm 폭 이하 Roll Film
	Slit Coater	1,000,000	별도	100,000	장	Resist Coating	370mm x 470mm 사각 기판
	Aligner (Cr Mask)		Mask 별도	70,000	장	Pattern Exposure(No Align)	2"~ 16" 및 조각 시편, 415mm x 510mm 이하 사각 기판, Pattern L/S : 6μm/6μm
			Mask 별도	100,000	장	Pattern Exposure(Auto Align)	13.4"~16" , 200mm x 300mm 이상 사각 기판, Pattern L/S : 6μm/6μm
	LDI 노광기	200,000		100,000	장	Pattern Exposure(Auto Align)	기본료: 도면설계 및 Setup 비용 (도면별 청구, 최초 1회 발생) Pattern L/S : 15μm/15μm
	Stepper	1,000,000	Mask 별도	300,000	장	Pattern Exposure(Auto Align)	기본료: 도면표설계및 보정 등 Setup 비용 370mm x 470mm 사각 기판, Pattern L/S : 0.5μm / 0.5μm
	Developer	200,000	70,000	30,000	장	Develop(Spray)	2"~ 14" 및 조각 시편, 370mm x 470mm 이하 사각 기판, TMAH 2.38% only
				50,000	장	Develop(Dipping)	2"~ 17" 및 조각 시편, 450mm x 550mm 이하 사각 기판, TMAH 2.38% 외 사용 가능 (기타재료비 별도)
		1,000,000		50,000	장	Inline Develop	370mm x 470mm 사각 기판
	Wet Etcher		별도	100,000	장	Pattern Wet Etch (Dipping)	2"~ 17" 및 조각 시편, 450mm x 550mm 이하 사각 기판, Etchant 재료비 별도
	Dry Etcher	200,000		200,000	장	RIE	370mm x 470mm 이하 기판, 시편, Wafer
	PR Strip		별도	100,000	장	Pattern PR Strip	2"~ 17" Wafer 및 조각 시편, 450mm x 550mm 이하 사각 기판, Stripper 재료비 별도
	Convection Oven			30,000	hr	Bake	O2 Type : Max 350°C, Max Size 415mm x 520mm 사각 기판 N2 Type : Max 250°C, Max Size 415mm x 510mm 사각 기판
	HotPlate			30,000	hr	Bake	Max 300°C, Max Size 500mm x 700mm 사각 기판
절단	diamond wheel cutter			60,000	장	Scribing	420mm x 520mm 이하 기판, 시편, Wafer(Glass 재질) , 세정 및 포장 별도
측정	AFM			50,000	hr		측정가능 시편 Size : 10mm x 10mm ~ 100mm x 100mm
	Spectrophotometer			50,000	hr	절대반사율, 광투과율 측정	측정가능 시편 - 반사율 : 20mm x 20mm ~ 120mm x 120mm - 투과율 : 50mm x 50mm ~ 120mm x 120mm
	4 point probe	50,000		50,000	hr	면저항 측정	측정 가능 시편 : 5mm x 5mm 이상
	Alpha step	80,000		20,000	hr	박막 두께 측정	측정 가능 시편 : - 기판 Size : 100mm x 100mm 이하 - 패턴 선포 : 20μm 이상 - 박막 두께 : 5nm ~ 400 μm
	Mini-SEM		별도	100,000	hr	구조 분석	해상도 : Max 100,000 (상담 후 결정)
	광학현미경			5,000	장	패턴 형상 및 선포 측정	현미경 Stage 115x115mm